

SG-112

SG-112 は、高出力赤外発光ダイオードと、高感度フォトトランジスタを組み合わせた反射型フォトインタラプタです。ペーパーセンサとして最適です。

The SG-112 reflective sensor for paper sensing combine high-output GaAs IRED with high sensitive phototransistor. It is most applicable to paper sensor.

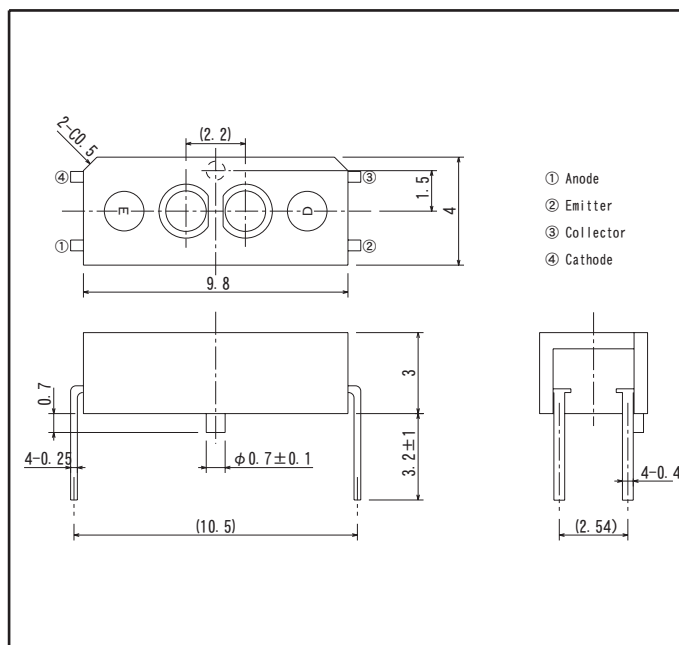
■特長 FEATURES

- 基板直付けタイプ
- 最適検出距離: 2.0mm
- 位置決めボス付き
- 薄型
- PWB direct mount type
- The most suitable detection distance 2.0mm
- With the installation positioning boss
- Low profile

■用途 APPLICATIONS

- プリンター
- FAX
- CD-ROM
- DVD-ROM
- Printers
- Facsimiles
- CD-ROM drives
- DVD-ROM drives

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
入力 Input	許容損失 Power dissipation	P _D	75	mW
	順電流 Forward current	I _F	50	mA
	逆電圧 Reverse voltage	V _R	5	V
	パルス順電流 Pulse forward current *1	I _{FP}	1	A
出力 Output	コレクタ損失 Collector power dissipation	P _C	75	mW
	コレクタ電流 Collector current	I _C	20	mA
	コレクタ-エミッタ間電圧 Collector-Emitter voltage	V _{CE0}	30	V
	エミッタ-コレクタ間電圧 Emitter-Collector voltage	V _{EC0}	5	V
動作温度 Operating temp. *2		T _{opr}	-20~+85	°C
保存温度 Storage temp. *2		T _{stg}	-30~+85	°C
半田付温度 Soldering temp. *3		T _{sol}	260	°C

- *1. パルス幅: $t_w \leq 100 \mu s$ 周期: $T=10ms$
pulse width: $t_w \leq 100 \mu s$ period: $T=10ms$
- *2. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew
- *3. ケース端面より 1mm 離れた所で $t \leq 5s$
For MAX. 5 seconds at the position of 1mm from the resin edge

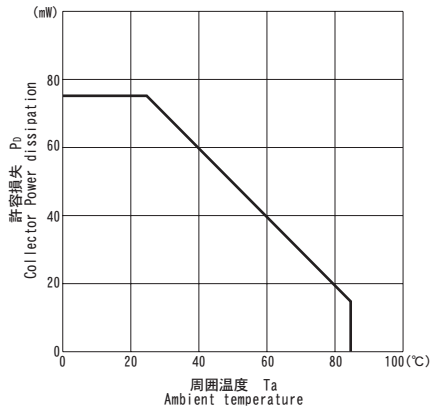
■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

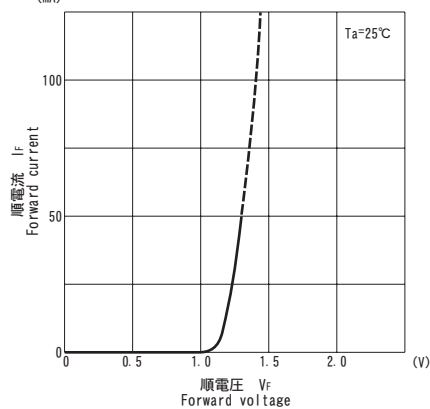
Item		Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
入力 Input	順電圧 Forward voltage	V _F	I _F =20mA	—	1.2	1.4	V
	逆電流 Reverse current	I _R	V _R =5V	—	—	10	μA
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ_p	I _F =20mA	—	940	—	nm
出力 Output	暗電流 Collector dark current	I _{CE0}	V _{CE} =10V E _R =0 I _x	—	1	100	nA
伝達特性 Transmission	光電流 Light current	I _L	I _F =20mA, V _{CE} =5V, L=2mm コダック90%反射紙	0.2	—	2.4	mA
	漏れ電流 Leakage current	I _{CE0D}	I _F =20mA, V _{CE} =5V, 反射物無し (Non-reflector)	—	—	20	μA
	コレクタ-エミッタ間飽和電圧 C-E saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _F =20mA, I _C =0.1mA	—	0.15	0.4	V
応答時間 (立ち上がり) Rise time		t _r	V _{CC} =5V, I _C =0.3mA, R _L =100 Ω	—	5	—	μs
応答時間 (立ち下がり) Fall time		t _f		—	5	—	μs

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

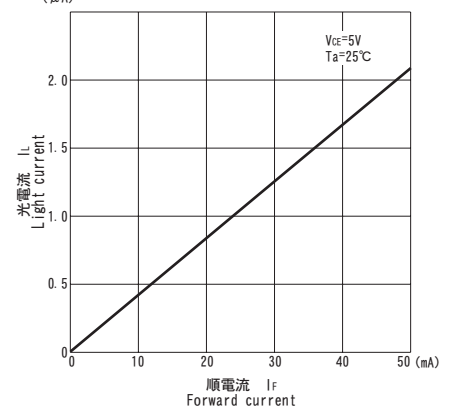
■許容損失/周囲温度 P_D/T_a



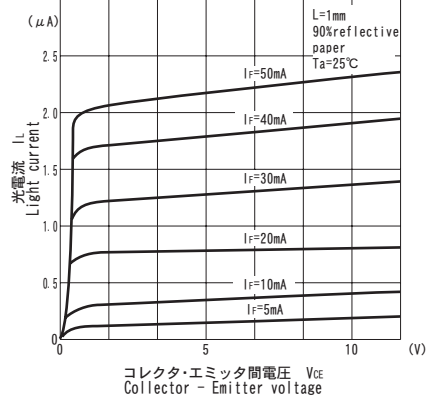
■順電流/順電圧特性 I_F/V_F



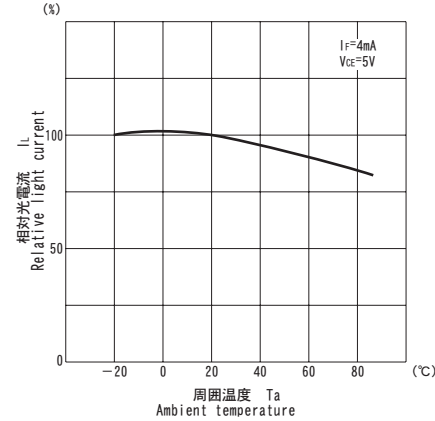
■光電流/順電流特性 I_L/I_F



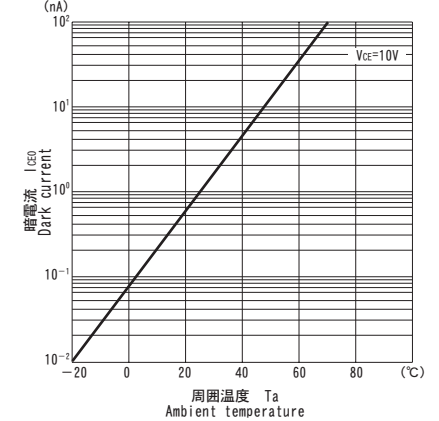
■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_L/V_{CE}



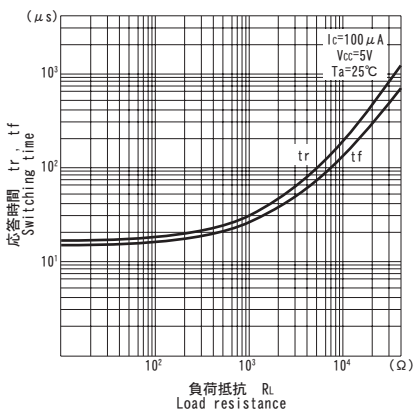
■相対光電流/周囲温度特性 I_L/T_a



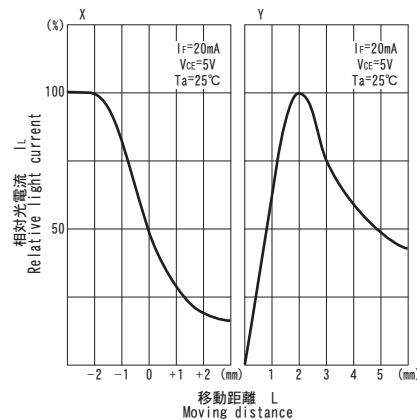
■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a



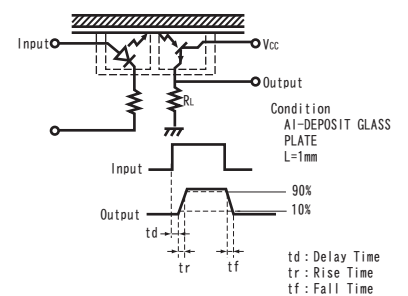
■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ ※1



■位置検出特性 ※2



*1 Switching time measurement circuit



*2 Method of measuring position detection characteristic

